



---

**HY2111**

**规格书**

1 节锂离子/锂聚合物电池保护 IC

## 目 录

1. 概述 .....	4
2. 特点 .....	4
3. 应用 .....	4
4. 方框图.....	5
5. 订购信息 .....	5
6. 产品目录 .....	6
7. 封装、脚位及标记信息 .....	8
8. 绝对最大额定值 .....	9
9. 电气特性 .....	10
10. 电池保护IC应用电路示例.....	11
11. 工作说明 .....	12
11.1. 正常工作状态.....	12
11.2. 过充电状态 .....	12
11.3. 过放电状态及休眠状态 .....	12
11.4. 放电过流状态（放电过流检测功能和负载短路检测功能） .....	13
11.5. 充电过流状态.....	13
11.6. 向 0V 电池充电功能（允许） .....	14
11.7. 向 0V 电池充电功能（禁止） .....	14
12. 特性（典型数据） .....	15
13. 封装信息 .....	18
13.1. DFN6 封装.....	18
13.2. SOT-23-6 封装（有 2 种不同尺寸规格） .....	19
14. 修订记录 .....	21

## 注意：

- 1、本说明书中的内容，随着产品的改进，有可能不经过预告而更改。请客户及时到本公司网站下载更新 <http://www.hycontek.com>。
- 2、本规格书中的图形、应用电路等，因第三方工业所有权引发的问题，本公司不承担其责任。
- 3、本产品在单独应用的情况下，本公司保证它的性能、典型应用和功能符合说明书中的条件。当使用在客户的产品或设备中，以上条件我们不作保证，建议客户做充分的评估和测试。
- 4、请注意输入电压、输出电压、负载电流的使用条件，使 IC 内的功耗不超过封装的容许功耗。对于客户在超出说明书中规定额定值使用产品，即使是瞬间的使用，由此所造成的损失，本公司不承担任何责任。
- 5、本产品虽内置防静电保护电路，但请不要施加超过保护电路性能的过大静电。
- 6、本规格书中的产品，未经书面许可，不可使用在要求高可靠性的电路中。例如健康医疗器械、防灾器械、车辆器械、车载器械及航空器械等对人体产生影响的器械或装置，不得作为其部件使用。
- 7、本公司一直致力于提高产品的质量和可靠度，但所有的半导体产品都有一定的失效概率，这些失效概率可能会导致一些人身事故、火灾事故等。当设计产品时，请充分留意冗余设计并采用安全指标，这样可以避免事故的发生。
- 8、本规格书中内容，未经本公司许可，严禁用于其它目的之转载或复制。

## 1. 概述

HY2111 系列 IC，内置高精度电压检测电路和延迟电路，是用于单节锂离子/锂聚合物可再充电电池的保护 IC。

本 IC 适合于对 1 节锂离子/锂聚合物可再充电电池的过充电、过放电和过电流进行保护。

## 2. 特点

HY2111 全系列 IC 具备如下特点：

### (1) 高精度电压检测电路

- |            |              |          |
|------------|--------------|----------|
| ● 过充电检测电压  | 4.200~4.400V | 精度±25mV  |
| ● 过充电释放电压  | 3.900~4.400V | 精度±50mV  |
| ● 过放电检测电压  | 2.30~3.00V   | 精度±80mV  |
| ● 过放电释放电压  | 2.30~3.40V   | 精度±80mV  |
| ● 放电过流检测电压 | (可选择)        |          |
| ● 充电过流检测电压 | -100mV (固定)  | 精度±40mV  |
| ● 负载短路检测电压 | 0.85V (固定)   | 精度±300mV |

### (2) 各延迟时间由内部电路设置 (不需外接电容)

- |              |           |
|--------------|-----------|
| ● 过充电检测延迟时间  | 典型值 100ms |
| ● 过放电检测延迟时间  | 典型值 25ms  |
| ● 放电过流检测延迟时间 | 典型值 10ms  |
| ● 充电过流检测延迟时间 | 典型值 12ms  |
| ● 负载短路检测延迟时间 | 典型值 500μs |

### (3) 休眠功能：可以选择“有”或“无” (详见产品目录)

### (4) 过放自恢复功能：可以选择“有”或“无” (详见产品目录)

### (5) 低耗电流 (具有休眠功能的型号)

- |        |                                |
|--------|--------------------------------|
| ● 工作模式 | 典型值 3.0μA，最大值 6.0μA (VDD=3.9V) |
| ● 休眠模式 | 最大值 0.1μA (VDD=2.0V)           |

### (6) 连接充电器的端子采用高耐压设计 (CS 端子和 OC 端子，绝对最大额定值是 20V)

### (7) 向 0V 电池充电功能：可以选择“允许”或“禁止” (详见产品目录)

### (8) 宽工作温度范围： -40℃~+85℃

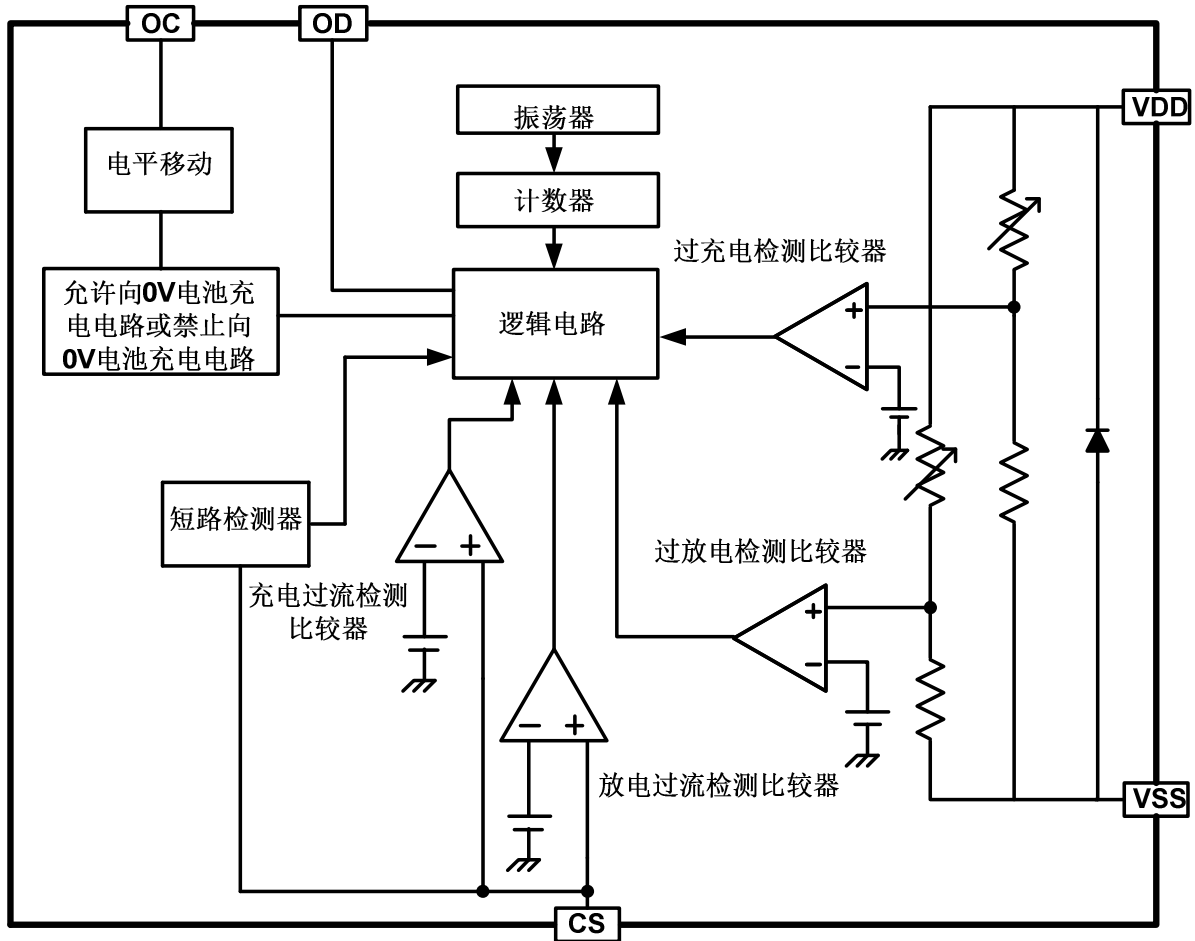
### (9) 小型封装： DFN6 & SOT-23-6

### (10) 无卤素绿色环保产品

## 3. 应用

- 1 节锂离子可再充电电池组
- 1 节锂聚合物可再充电电池组

### 4. 方框图



### 5. 订购信息

- 产品名称定义

HY2111-XX

封装名称

A: DFN6

B: SOT-23-6

序列号

按A~Z顺序设定

## 6. 产品目录

## ● DFN6 封装

型号	过充电 检测电 压	过充电 释放电 压	过放电 检测电 压	过放电 释放电 压	放电过流检 测电压	充电过流检 测电压	向 0V 电池充 电功能	其它功能
	V <sub>CU</sub>	V <sub>CR</sub>	V <sub>DL</sub>	V <sub>DR</sub>	V <sub>DIP</sub>	V <sub>CIP</sub>	V <sub>OCH</sub>	-
HY2111-AA	4.28V	4.08V	2.40V	2.50V	50±16mV	-100mV	允许	有休眠功能
HY2111-BA	4.28V	4.08V	2.40V	2.50V	75±25mV	-100mV	允许	有休眠功能
HY2111-CA	4.28V	4.08V	2.90V	3.00V	50±16mV	-100mV	允许	有休眠功能
HY2111-DA	4.28V	4.08V	2.90V	3.00V	75±25mV	-100mV	允许	有休眠功能
HY2111-EA	4.28V	4.08V	2.40V	2.50V	150±25mV	-100mV	允许	有休眠功能
HY2111-FA	4.28V	4.08V	2.40V	2.50V	200±25mV	-100mV	允许	有休眠功能
HY2111-GA	4.28V	4.08V	2.90V	3.00V	150±25mV	-100mV	允许	有休眠功能
HY2111-HA	4.28V	4.08V	2.90V	3.00V	200±25mV	-100mV	允许	有休眠功能
HY2111-IA	4.28V	4.08V	2.40V	2.50V	100±25mV	-100mV	允许	有休眠功能
HY2111-JA	4.28V	4.08V	2.90V	3.00V	100±25mV	-100mV	允许	有休眠功能
HY2111-KA	4.28V	4.08V	2.40V	2.50V	225±30mV	-100mV	允许	有过放自恢复功能
HY2111-LA	4.20V	4.00V	2.85V	2.94V	150±25mV	-100mV	允许	有休眠功能
HY2111-MA	4.25V	4.05V	2.40V	2.50V	150±30mV	-100mV	允许	有休眠功能

备注：需要上述规格以外的产品时，请与本公司业务部联系。

● SOT-23-6 封装

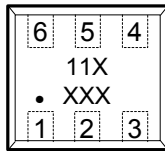
参数 型号	过充电 检测电 压	过充电 释放电 压	过放电 检测电 压	过放电 释放电 压	放电过流检 测电压	充电过流检 测电压	向 0V 电池充 电功能	其它功能
	V <sub>CU</sub>	V <sub>CR</sub>	V <sub>DL</sub>	V <sub>DR</sub>	V <sub>DIP</sub>	V <sub>CIP</sub>	V <sub>OCH</sub>	-
HY2111-AB	4.28V	4.08V	2.40V	2.50V	50±16mV	-100mV	允许	有休眠功能
HY2111-BB	4.28V	4.08V	2.40V	2.50V	75±25mV	-100mV	允许	有休眠功能
HY2111-CB	4.28V	4.08V	2.90V	3.00V	50±16mV	-100mV	允许	有休眠功能
HY2111-DB	4.28V	4.08V	2.90V	3.00V	75±25mV	-100mV	允许	有休眠功能
HY2111-EB	4.28V	4.08V	2.40V	2.50V	150±25mV	-100mV	允许	有休眠功能
HY2111-FB	4.28V	4.08V	2.40V	2.50V	200±25mV	-100mV	允许	有休眠功能
HY2111-GB	4.28V	4.08V	2.90V	3.00V	150±25mV	-100mV	允许	有休眠功能
HY2111-HB	4.28V	4.08V	2.90V	3.00V	200±25mV	-100mV	允许	有休眠功能
HY2111-IB	4.28V	4.08V	2.40V	2.50V	100±25mV	-100mV	允许	有休眠功能
HY2111-JB	4.28V	4.08V	2.90V	3.00V	100±25mV	-100mV	允许	有休眠功能
HY2111-KB	4.28V	4.08V	2.40V	2.50V	225±30mV	-100mV	允许	有过放自恢复功能
HY2111-LB	4.20V	4.00V	2.85V	2.94V	150±25mV	-100mV	允许	有休眠功能
HY2111-MB	4.25V	4.05V	2.40V	2.50V	150±30mV	-100mV	允许	有休眠功能

备注：需要上述规格以外的产品时，请与本公司业务部联系。

### 7. 封装、脚位及标记信息

#### ● DFN6 封装

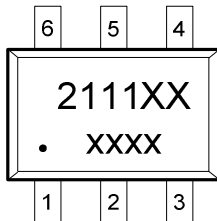
脚位	符号	说明
1	NC	无连接
2	OC	充电控制用 MOSFET 门极连接端子
3	OD	放电控制用 MOSFET 门极连接端子
4	VSS	接地端，负电源输入端子
5	VDD	电源端，正电源输入端子
6	CS	过电流检测输入端子，充电器检测端子



11：产品名称  
 X：产品序列号  
 xxx：日期编码

#### ● SOT-23-6 封装

脚位	符号	说明
1	OD	放电控制用 MOSFET 门极连接端子
2	CS	过电流检测输入端子，充电器检测端子
3	OC	充电控制用 MOSFET 门极连接端子
4	NC	无连接
5	VDD	电源端，正电源输入端子
6	VSS	接地端，负电源输入端子



2111：产品名称  
 XX：产品序列号  
 xxxx：日期编码



## 8. 绝对最大额定值

(VSS=0V, Ta=25℃, 除非特别说明)

项目	符号	规格	单位
VDD 和 VSS 之间输入电压	V <sub>DD</sub>	VSS-0.3~VSS+10	V
OC 输出端子电压	V <sub>OC</sub>	VDD-20~VDD+0.3	V
OD 输出端子电压	V <sub>OD</sub>	VSS-0.3~VDD+0.3	V
CS 输入端子电压	V <sub>CS</sub>	VDD-20~VDD+0.3	V
工作温度范围	T <sub>OP</sub>	-40~+85	℃
储存温度范围	T <sub>ST</sub>	-40~+125	℃
容许功耗	P <sub>D</sub>	250	mW

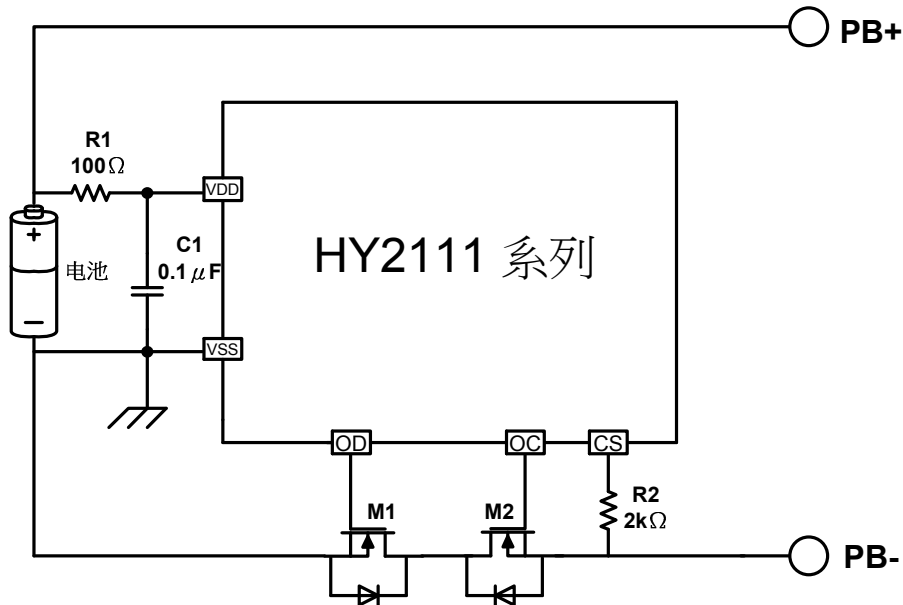
## 9. 电气特性

(VSS=0V, Ta=25°C, 除非特别说明)

项目	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压						
VDD-VSS 工作电压	V <sub>DSOP1</sub>	-	1.5	-	8	V
VDD-CS 工作电压	V <sub>DSOP2</sub>	-	1.5	-	20	V
耗电流 (有休眠功能的型号)						
工作电流	I <sub>DD</sub>	V <sub>DD</sub> =3.9V	-	3.0	6.0	μA
休眠电流	I <sub>PD</sub>	V <sub>DD</sub> =2.0V	-	-	0.1	μA
耗电流 (有过放自恢复功能的型号)						
工作电流	I <sub>DD</sub>	V <sub>DD</sub> =3.9V	-	3.0	6.0	μA
过放电时耗电流	I <sub>OD</sub>	V <sub>DD</sub> =2.0V	-	2.0	3.0	μA
检测电压						
过充电检测电压	V <sub>CU</sub>	4.2~4.4V, 可调整	V <sub>CU</sub> -0.025	V <sub>CU</sub>	V <sub>CU</sub> +0.025	V
		4.2~4.4V, 可调整 -5°C~55°C (*1)	V <sub>CU</sub> -0.035	V <sub>CU</sub>	V <sub>CU</sub> +0.035	V
过充电释放电压	V <sub>CR</sub>	3.9~4.4V, 可调整	V <sub>CR</sub> -0.05	V <sub>CR</sub>	V <sub>CR</sub> +0.05	V
过放电检测电压	V <sub>DL</sub>	2.3~3.0V, 可调整	V <sub>DL</sub> -0.08	V <sub>DL</sub>	V <sub>DL</sub> +0.08	V
过放电释放电压	V <sub>DR</sub>	2.3~3.4V, 可调整	V <sub>DR</sub> -0.08	V <sub>DR</sub>	V <sub>DR</sub> +0.08	V
放电过流检测电压	V <sub>DIP</sub>	V <sub>DD</sub> =3.6V, V <sub>DIP</sub> =50mV	V <sub>DIP</sub> -16	V <sub>DIP</sub>	V <sub>DIP</sub> +16	mV
		V <sub>DD</sub> =3.6V, 50mV<V <sub>DIP</sub> <225mV	V <sub>DIP</sub> -25	V <sub>DIP</sub>	V <sub>DIP</sub> +25	mV
		V <sub>DD</sub> =3.6V, V <sub>DIP</sub> ≥225mV 及HY2111-M	V <sub>DIP</sub> -30	V <sub>DIP</sub>	V <sub>DIP</sub> +30	mV
负载短路检测电压	V <sub>SIP</sub>	V <sub>DD</sub> =3.0V	0.55	0.85	1.15	V
充电过流检测电压	V <sub>CIP</sub>		-140	-100	-60	mV
延迟时间						
过充电检测延迟时间	T <sub>OC</sub>		50	100	150	ms
过放电检测延迟时间	T <sub>OD</sub>	V <sub>DD</sub> =3.6V→2.0V	10	25	40	ms
放电过流检测延迟时间	T <sub>DIP</sub>	V <sub>DD</sub> =3.6V	5	10	15	ms
充电过流检测延迟时间	T <sub>CIP</sub>	V <sub>DD</sub> =3.6V, CS=-0.2V	7	12	17	ms
负载短路检测延迟时间	T <sub>SIP</sub>	V <sub>DD</sub> =3.0V	-	500	700	μs
控制端子输出电压						
OD 端子输出高电压	V <sub>DH</sub>		VDD-0.1	VDD-0.02	-	V
OD 端子输出低电压	V <sub>DL</sub>		-	0.1	0.5	V
OC 端子输出高电压	V <sub>CH</sub>		VDD-0.1	VDD-0.02	-	V
OC 端子输出低电压	V <sub>CL</sub>		-	0.1	0.5	V
向 0V 电池充电的功能 (允许或禁止)						
充电器起始电压 (允许向 0V 电池充电功能)	V <sub>0CH</sub>	允许向 0V 电池充电功能	1.2	-	-	V
电池电压 (禁止向 0V 电池充电功能)	V <sub>0IN</sub>	禁止向 0V 电池充电功能	-	-	0.5	V

说明: \*1、此温度范围内的参数是设计保证值, 而非高、低温实测筛选。

## 10. 电池保护 IC 应用电路示例



标记	器件名称	用途	最小值	典型值	最大值	说明
<b>R1</b>	电阻	限流、稳定VDD、加强ESD	100Ω	<b>100Ω</b>	200Ω	*1
<b>R2</b>	电阻	限流	1kΩ	<b>2kΩ</b>	2kΩ	*2
<b>C1</b>	电容	滤波，稳定VDD	0.01μF	<b>0.1μF</b>	1.0μF	*3
<b>M1</b>	N-MOSFET	放电控制	-	-	-	*4
<b>M2</b>	N-MOSFET	充电控制	-	-	-	*5

\*1、R1连接过大电阻，由于耗电流会在R1上产生压降，影响检测电压精度。当充电器反接时，电流从充电器流向IC，若R1过大有可能导致VDD-VSS端子间电压超过绝对最大额定值的情况发生。

\*2、R2 连接过大电阻，当连接高电压充电器时，有可能导致不能切断充电电流的情况发生。但为控制充电器反接时的电流，请尽可能选取较大的阻值。

\*3、C1有稳定VDD电压的作用，请不要连接0.01μF以下的电容。

\*4、使用MOSFET的阈值电压在过放电检测电压以上时，可能导致在过放电保护之前停止放电。

\*5、门极和源极之间耐压在充电器电压以下时，N-MOSFET有可能被损坏。

## 注意：

1. 上述参数有可能不经预告而作更改，请及时到网站上下载最新版规格书。

网址：<http://www.hycontek.com>。

2. 外围器件如需调整，建议客户进行充分的评估和测试。

## 11. 工作说明

### 11.1. 正常工作状态

此IC持续侦测连接在VDD和VSS之间的电池电压，以及CS与VSS之间的电压差，来控制充电和放电。当电池电压在过放电检测电压（ $V_{DL}$ ）以上并在过充电检测电压（ $V_{CU}$ ）以下，且CS端子电压在充电过流检测电压（ $V_{CIP}$ ）以上并在放电过流检测电压（ $V_{DIP}$ ）以下时，IC的OC和OD端子都输出高电平，使充电控制用MOSFET和放电控制用MOSFET同时导通，这个状态称为“正常工作状态”。此状态下，充电和放电都可以自由进行。

**注意：**初次连接电芯时，会有不能放电的可能性，此时，短接CS端子和VSS端子，或者连接充电器，就能恢复到正常工作状态。

### 11.2. 过充电状态

正常工作状态下的电池，在充电过程中，一旦电池电压超过过充电检测电压（ $V_{CU}$ ），并且这种状态持续的时间超过过充电检测延迟时间（ $T_{OC}$ ）以上时，HY2111系列IC会关闭充电控制用的MOSFET（OC端子），停止充电，这个状态称为“过充电状态”。

过充电状态在如下2种情况下可以释放：

不连接充电器时，

(1) 由于自放电使电池电压降低到过充电释放电压（ $V_{CR}$ ）以下时，过充电状态释放，恢复到正常工作状态。

(2) 连接负载放电，放电电流先通过充电控制用MOSFET的寄生二极管流过，此时，CS端子侦测到一个“二极管正向导通压降（ $V_f$ ）”的电压。当CS端子电压在放电过流检测电压（ $V_{DIP}$ ）以上且电池电压降低到过充电检测电压（ $V_{CU}$ ）以下时，过充电状态释放，恢复到正常工作状态。

**注意：**进入过充电状态的电池，如果仍然连接着充电器，即使电池电压低于过充电释放电压（ $V_{CR}$ ），过充电状态也不能释放。断开充电器，CS端子电压上升到充电过流检测电压（ $V_{CIP}$ ）以上时，过充电状态才能释放。

### 11.3. 过放电状态及休眠状态

#### 11.3.1. 有休眠功能的型号

正常工作状态下的电池，在放电过程中，当电池电压降低到过放电检测电压（ $V_{DL}$ ）以下，并且这种状态持续的时间超过过放电检测延迟时间（ $T_{OD}$ ）以上时，HY2111系列IC会关闭放电控制用的MOSFET（OD端子），停止放电，这个状态称为“过放电状态”。

当关闭放电控制用MOSFET后，CS由IC内部电阻上拉到VDD，使IC耗电流减小到休眠时的耗电流值，这个状态称为“休眠状态”。

过放电状态的释放，有以下两种情况：

(1) 连接充电器，若CS端子电压低于充电过流检测电压（ $V_{CIP}$ ），当电池电压高于过放电检测电压（ $V_{DL}$ ）时，过放电状态释放，恢复到正常工作状态。

(2) 连接充电器，若CS端子电压高于充电过流检测电压（ $V_{CIP}$ ），当电池电压高于过放

电释放电压 ( $V_{DR}$ ) 时, 过放电状态释放, 恢复到正常工作状态。

### 11.3.2. 有过放自恢复功能的型号

正常工作状态下的电池, 在放电过程中, 当电池电压降低到过放电检测电压 ( $V_{DL}$ ) 以下, 并且这种状态持续的时间超过过放电检测延迟时间 ( $T_{OD}$ ) 以上时, HY2111 系列 IC 会关闭放电控制用的 MOSFET (OD 端子), 停止放电, 这个状态称为“过放电状态”。

过放电状态的释放, 有以下三种方法:

(1) 连接充电器, 若 CS 端子电压低于充电过流检测电压 ( $V_{CIP}$ ), 当电池电压高于过放电检测电压 ( $V_{DL}$ ) 时, 过放电状态释放, 恢复到正常工作状态。

(2) 连接充电器, 若 CS 端子电压高于充电过流检测电压 ( $V_{CIP}$ ), 当电池电压高于过放电释放电压 ( $V_{DR}$ ) 时, 过放电状态释放, 恢复到正常工作状态。

(3) 没有连接充电器时, 如果电池电压自恢复到高于过放电释放电压 ( $V_{DR}$ ) 时, 过放电状态释放, 恢复到正常工作状态, 即有过放自恢复功能。

### 11.4. 放电过流状态 (放电过流检测功能和负载短路检测功能)

正常工作状态下的电池, HY2111 通过检测 CS 端子电压持续侦测放电电流。一旦 CS 端子电压超过放电过流检测电压 ( $V_{DIP}$ ), 并且这种状态持续的时间超过放电过流检测延迟时间 ( $T_{DIP}$ ), 则关闭放电控制用的 MOSFET (OD 端子), 停止放电, 这个状态称为“放电过流状态”。

而一旦 CS 端子电压超过负载短路检测电压 ( $V_{SIP}$ ), 并且这种状态持续的时间超过负载短路检测延迟时间 ( $T_{SIP}$ ), 则也关闭放电控制用的 MOSFET (OD 端子), 停止放电, 这个状态称为“负载短路状态”。

当连接在电池正极 (PB+) 和电池负极 (PB-) 之间的阻抗大于放电过流/负载短路释放阻抗时, 放电过流状态和负载短路状态释放, 恢复到正常工作状态。另外, 即使连接在电池正极 (PB+) 和电池负极 (PB-) 之间的阻抗小于放电过流/负载短路释放阻抗, 当连接上充电器, CS 端子电压降低到放电过流保护电压 ( $V_{DIP}$ ) 以下, 也会释放放电过流状态或负载短路状态, 回到正常工作状态。

放电过流/负载短路释放阻抗的计算公式:  $[(150\text{mV}/V_{DIP}) * 450\text{k}\Omega]$  (typ.)

注意:

(1) 放电过流/负载短路释放阻抗, 与电池电压及过流检测电压 ( $V_{DIP}$ ) 有关。

(2) 若不慎将充电器反接时, 回路中的电流方向与放电时电流方向一致, 如果 CS 端子电压高于放电过流检测电压 ( $V_{DIP}$ ), 则可以进入放电过流保护状态, 切断回路中的电流, 起到保护的作用。

### 11.5. 充电过流状态

正常工作状态下的电池, 在充电过程中, 如果 CS 端子电压低于充电过流检测电压 ( $V_{CIP}$ ), 并且这种状态持续的时间超过充电过流检测延迟时间 ( $T_{CIP}$ ), 则关闭充电控制用的 MOSFET (OC 端子), 停止充电, 这个状态称为“充电过流状态”。

进入充电过流检测状态后，如果断开充电器使CS端子电压高于充电过流检测电压( $V_{CIP}$ )时，充电过流状态被解除，恢复到正常工作状态。

### 11.6. 向 0V 电池充电功能（允许）

此功能用于对已经自放电到 0V 的电池进行再充电。当连接在电池正极 (PB+) 和电池负极 (PB-) 之间的充电器电压，高于“向 0V 电池充电的充电器起始电压 ( $V_{0CH}$ )”时，充电控制用 MOSFET 的门极固定为 VDD 端子的电位，由于充电器电压使 MOSFET 的门极和源极之间的电压差高于其导通电压，充电控制用 MOSFET 导通 (OC 端子)，开始充电。这时，放电控制用 MOSFET 仍然是关断的，充电电流通过其内部寄生二极管流过。当电池电压高于过放电检测电压 ( $V_{DL}$ ) 时，HY2111 系列 IC 进入正常工作状态。

#### 注意：

1. 某些完全自放电后的电池，不允许被再次充电，这是由锂电池的特性决定的。请询问电池供应商，确认所购买的电池是否具备“允许向 0V 电池充电”的功能，还是“禁止向 0V 电池充电”的功能。

2. “允许向 0V 电池充电功能”比“充电过流检测功能”优先级更高。因此。使用“允许向 0V 电池充电”功能的 IC，在电池电压较低的时候会强制充电。电池电压低于过放电检测电压 ( $V_{DL}$ ) 以下时，不能进行充电过流状态的检测。

### 11.7. 向 0V 电池充电功能（禁止）

当连接内部短路的电池 (0V 电池) 时，禁止向 0V 电池充电的功能会阻止对它再充电。当电池电压低于“0V 电池充电禁止的电池电压 ( $V_{0IN}$ )”时，充电控制用 MOSFET 的门极固定为 PB- 电压，禁止充电。当电池电压高于“0V 电池充电禁止的电池电压 ( $V_{0IN}$ )”时，可以充电。

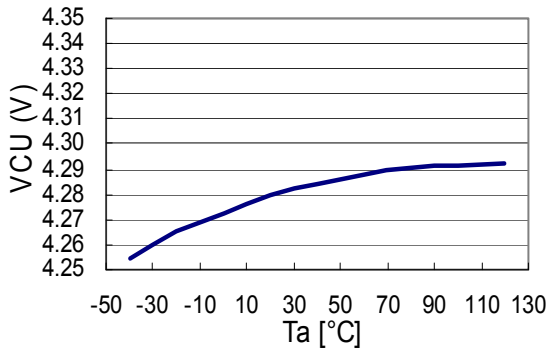
#### 注意：

1. 某些完全自放电后的电池，不允许被再次充电，这是由锂电池的特性决定的。请询问电池供应商，确认所购买的电池是否具备“允许向 0V 电池充电”的功能，还是“禁止向 0V 电池充电”的功能。

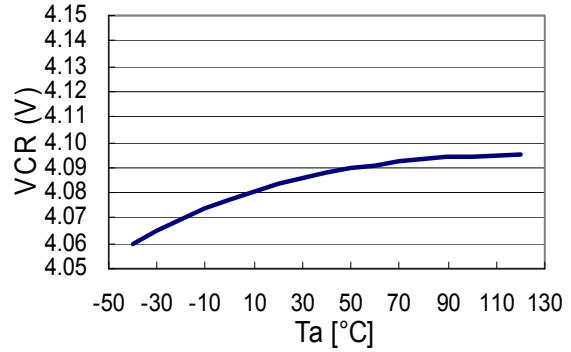
### 12. 特性（典型数据）

1. 过充电检测电压/过充电释放电压，过放电检测电压/过放电释放电压，放电过流检测电压/负载短路检测电压，充电过流检测电压以及各延迟时间

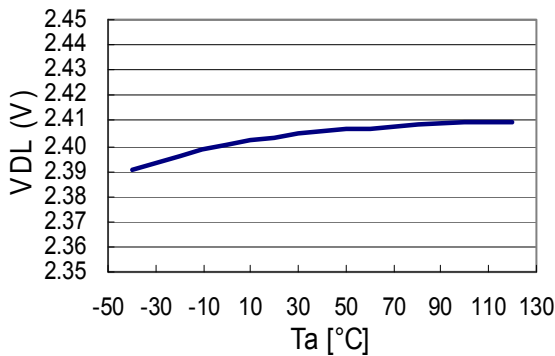
(1)  $V_{CU}$  vs.  $T_a$



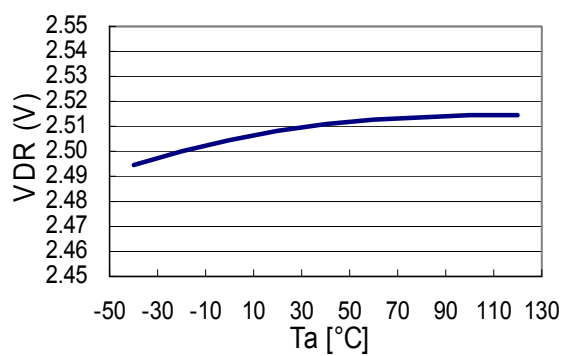
(2)  $V_{CR}$  vs.  $T_a$



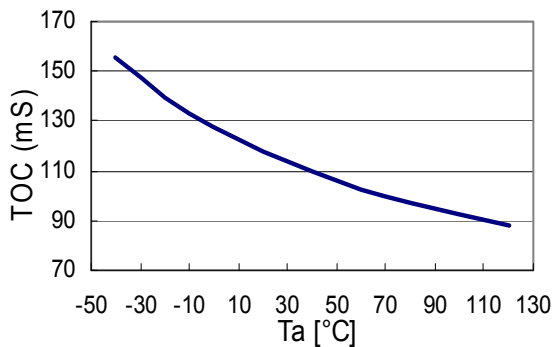
(3)  $V_{DL}$  vs.  $T_a$



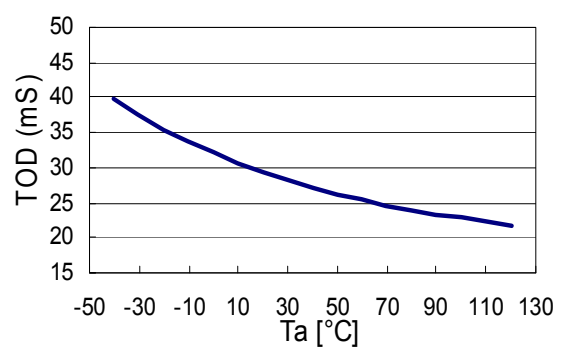
(4)  $V_{DR}$  vs.  $T_a$



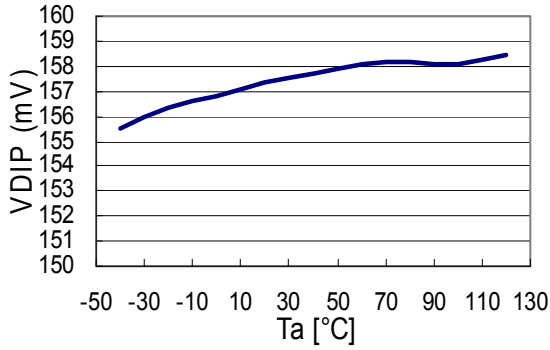
(5)  $T_{OC}$  vs.  $T_a$



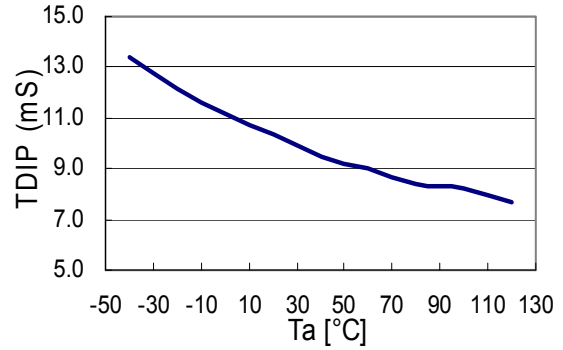
(6)  $T_{OD}$  vs.  $T_a$



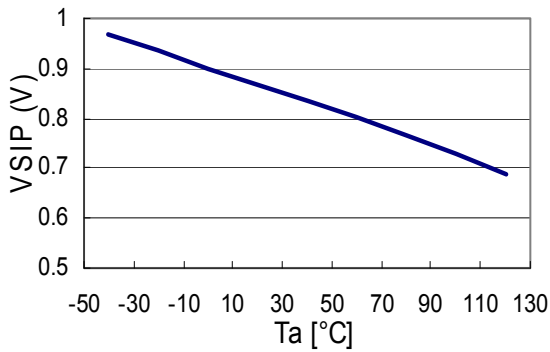
(7)  $V_{DIP}$  vs.  $T_a$



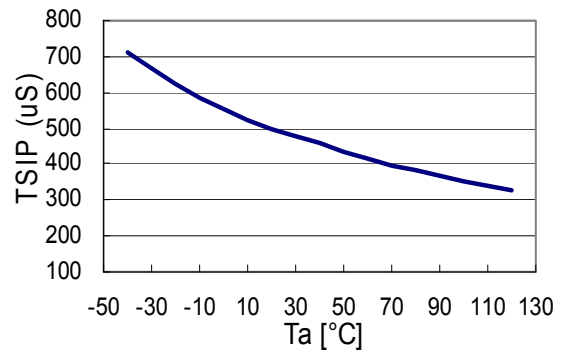
(8)  $T_{DIP}$  vs.  $T_a$



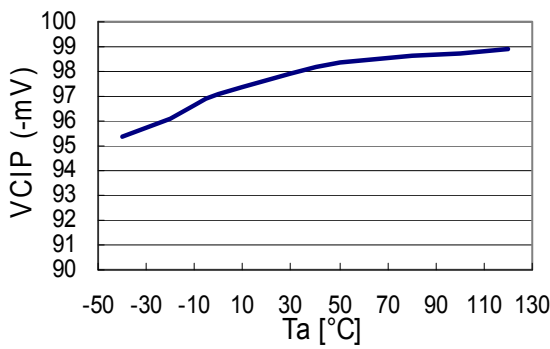
(9)  $V_{SIP}$  vs.  $T_a$



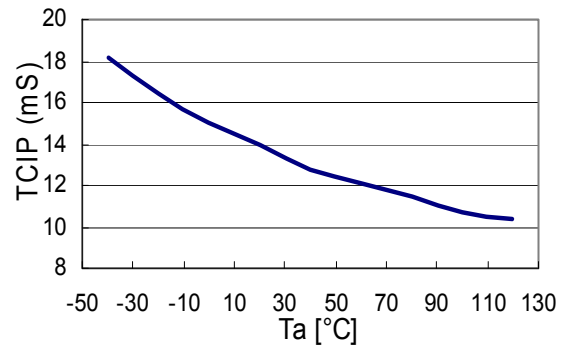
(10)  $T_{SIP}$  vs.  $T_a$



(11)  $V_{CIP}$  vs.  $T_a$



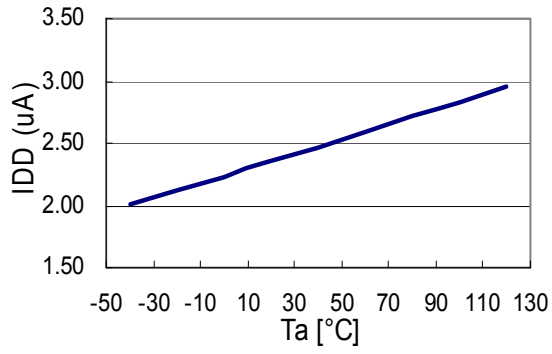
(12)  $T_{CIP}$  vs.  $T_a$



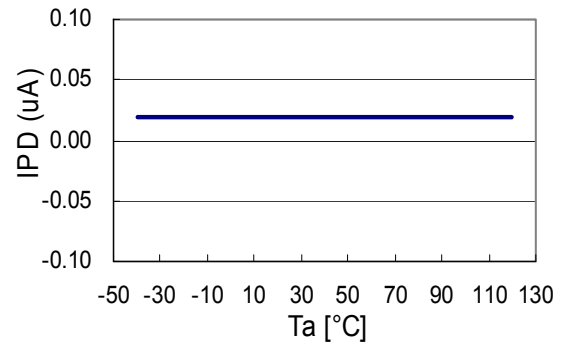


### 2. 耗电流

(13)  $I_{DD}$  vs.  $T_a$



(14)  $I_{PD}$  vs.  $T_a$

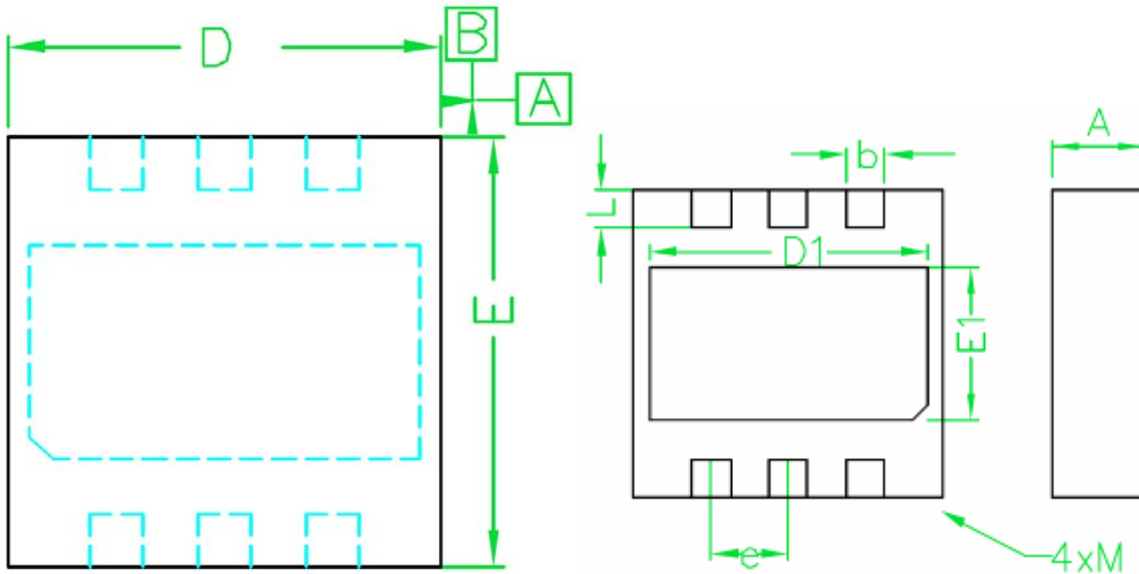


### 13. 封装信息

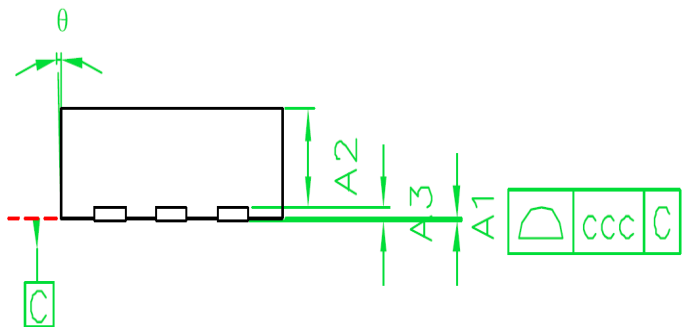
#### 13.1. DFN6 封装

说明:

1. 单位: mm。
2. 引脚和散热片的颜色是金色或者银色。



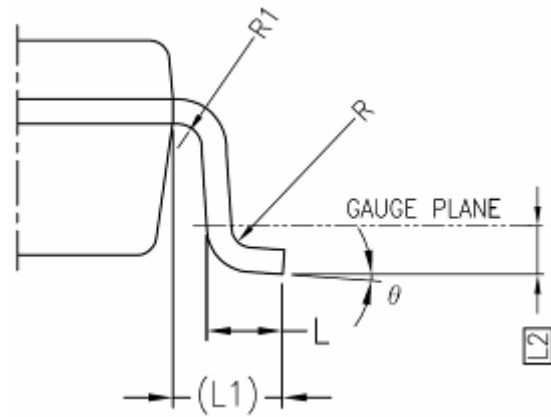
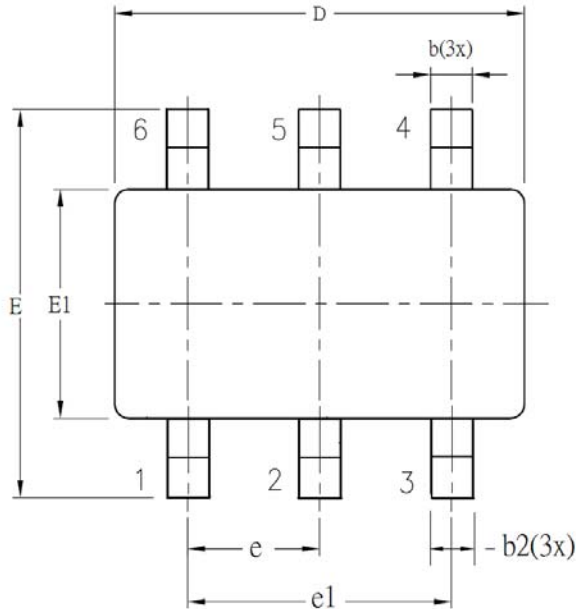
SYMBOLS	DIMENSIONS IN MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	0.55	0.60	0.65
A1	0.000	0.002	0.004
A2	0.51	0.54	0.59
A3	---	0.06REF	---
b	0.20	0.25	0.30
D	1.95	2.00	2.03
D1	---	1.8BSC	---
E	1.95	2.00	2.03
E1	---	1.0BSC	---
e	---	0.50BSC	---
L	0.20	0.25	0.30
$\theta$	-12	---	0
ccc	---	0.08	---
M	---	---	0.05
Burr	0.00	0.03	0.06



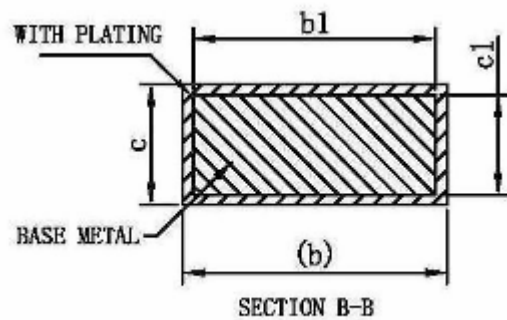
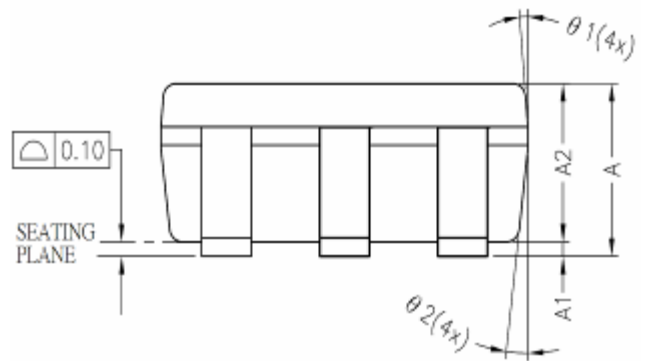
### 13.2. SOT-23-6 封装 (有 2 种不同尺寸规格)

#### 13.2.1. SOT-23-6 (第一种)

说明: 单位为 mm。

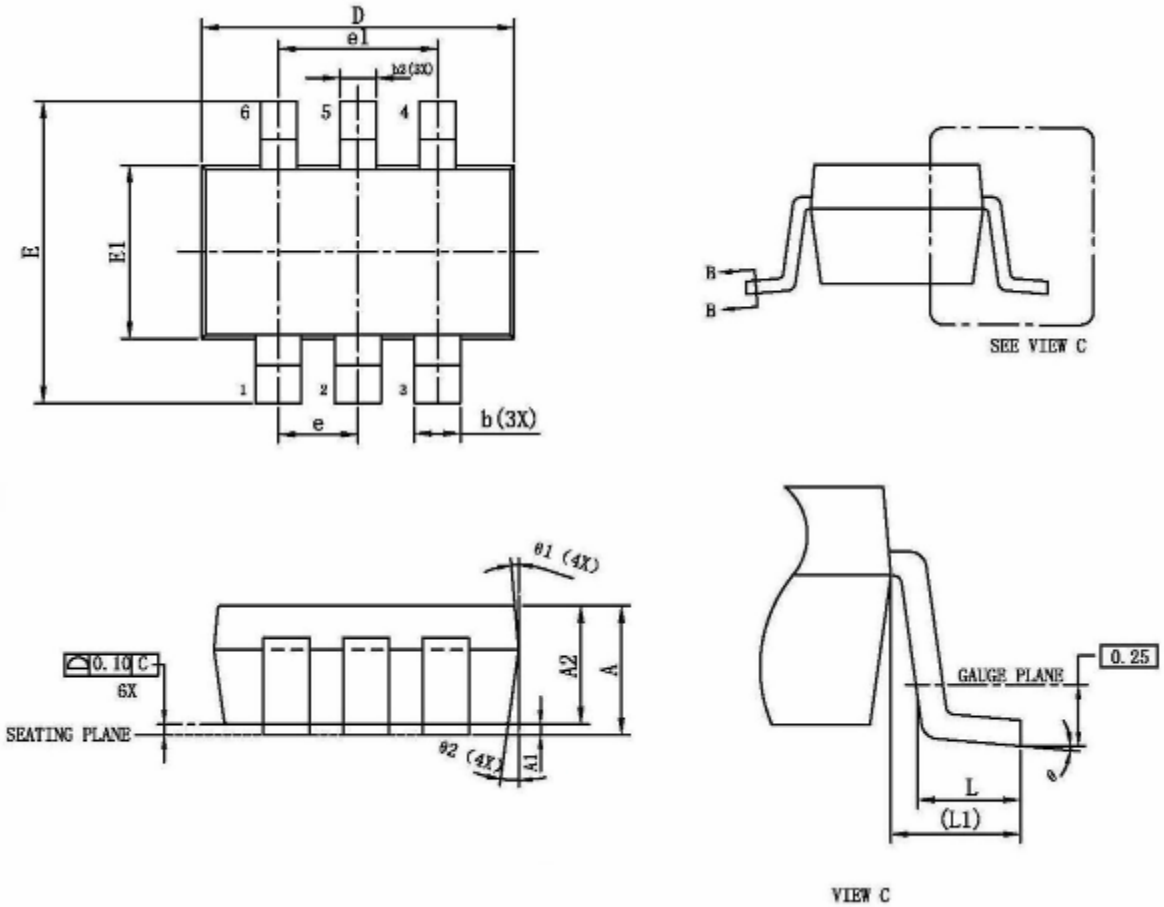


SYM BOL	ALL DIMENSIONS IN MILLIMETERS		
	MINIMUM	NOMINAL	MAXIMUM
A	-	1.30	1.40
A1	0	-	0.15
A2	0.90	1.20	1.30
b	0.30	-	0.50
b1	0.30	0.40	0.45
b2	0.30	0.40	0.50
c	0.08	-	0.22
c1	0.08	0.13	0.20
D	2.90 BSC		
E	2.80 BSC		
E1	1.60 BSC		
e	0.95 BSC		
e1	1.90 BSC		
L	0.30	0.45	0.60
L1	0.60 REF		
L2	0.25 BSC		
R	0.10	-	-
R1	0.10	-	0.25
θ	0°	4°	8°
θ1	5°	-	15°
θ2	5°	-	15°

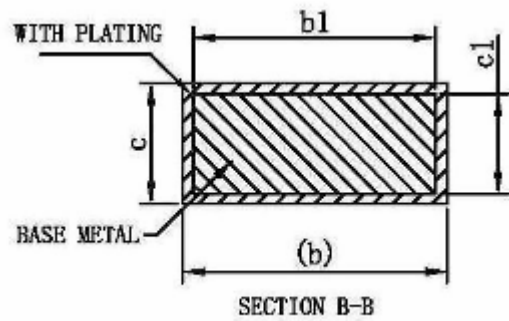


### 13.2.2. SOT-23-6 (第二种)

说明：单位为 mm。



SYM BOL	ALL DIMENSIONS IN MILLIMETERS		
	MINIMUM	NOMINAL	MAXIMUM
A	-	1.30	1.40
A1	0.05	-	0.15
A2	0.90	1.20	1.30
b	0.40	-	0.55
b1	0.40	0.45	0.50
b2	0.25	-	0.40
c	0.08	-	0.20
c1	0.08	0.11	0.15
D	2.70	2.90	3.00
E	2.60	2.80	3.00
E1	1.50	1.60	1.70
e	0.95 BSC		
e1	1.90 BSC		
L	0.35	0.45	0.55
L1	0.60 REF		
θ	0°	5°	10°
θ1	3°	5°	7°
θ2	6°	8°	10°



### 14. 修订记录

以下描述本文件差异较大的地方，而标点符号与字形的改变不在此描述范围。

---

版本	页次	变更摘要
V09	All	SOT-23-6 封装的 HY2111，其第 4 脚变更为 NC。
	All	增加新型号：HY2111-KA 和 HY2111-KB。
	19,20	修改封装尺寸。
V10	All	增加新型号：HY2111-LA 和 HY2111-LB。
V11	All	增加新型号：HY2111-MA 和 HY2111-MB。
	10	修改 R1 和 R2 选择范围。
	18	修改封装尺寸。
V12	All	修改 HY2111-KA 和 HY2111-KB 的 VDIP 参数，并增加过放自恢复功能。
V13	All	修改部分电气参数范围。去掉标记为“A”的 DFN6 封装，增加标记为“C”的新尺寸规格 DFN6 封装。
V14	All	删除标记为“C”的 DFN6 封装，增加标记为“A”的 DFN6 封装。